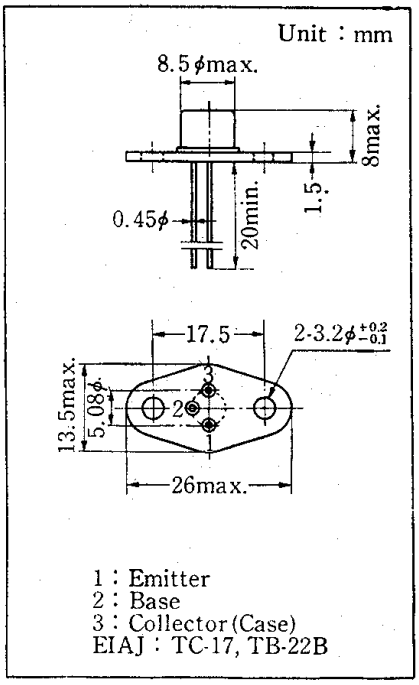
2SC697, 2SC697A

シリコン NPN エピタキシアルプレーナ型／Si NPN Epitaxial Planar

中電力増幅用／Medium Power Amplifier
2SA547, 2SA547A とコンプリメンタリ／Complementary pair with 2SA547, 2SA547A

特　徴／Features

- コレクタ・ベース電圧 V_{CBO} が大きい。／High V_{CBO}
- コレクタ電流 I_C が大きい。／High I_C



最大定格／Absolute Maximum Ratings (Ta=25°C)

Item		Symbol	Value	Unit
コレクタ・ベース電圧	2SC697	V_{CBO}	100	V
	2SC697A		130	
コレクタ・エミッタ電圧	2SC697	V_{CEO}	60	V
	2SC697A		80	
エミッタ・ベース電圧		V_{EBO}	5	V
コレクタ電流		I_C	3	A
ベース電流		I_B	0.6	A
コレクタ損失 (Tc=25°C)		P_C	10	W
接合部温度		T_j	175	°C
保存温度		T_{stg}	−65～+175	°C

電気的特性／Electrical Characteristics (Ta=25°C)

Item		Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタしゃ断電流		I_{CBO}	V_{CB}=30V, I_E=0			3	μA
	2SC697	I_{CEO}	V_{CE}=60V, I_B=0			5	mA
	2SC697A		V_{CE}=80V, I_B=0			5	
エミッタしゃ断電流		I_{EBO}	V_{EB}=5V, I_C=0			100	μA
直流電流増幅率		h_{FE1}*	V_{CE}=3V, I_C=100mA**	30		173	
		h_{FE2}	V_{CE}=3V, I_C=1A**	28			
トランジション周波数		f_T	V_{CB}=10V, $-I_E$=50mA	35			MHz
ベース・エミッタ電圧		V_{BE}	V_{CE}=3V, I_C=100mA**			0.8	V
コレクタ・エミッタ飽和電圧		$V_{CE(sat)}$	I_C=2A, I_B=0.4A**			0.8	V

** パルス測定／Pulse Test

* h_{FE1} ランク分類／h_{FE1} Classifications

h_{FE1}	30～50	38～77	57～115	85～173
分類	△J	△I, F	△H, E, △B	△D, △A

△ 保守ランク／Maintenance